

技術の名称

半導体レーザ装置

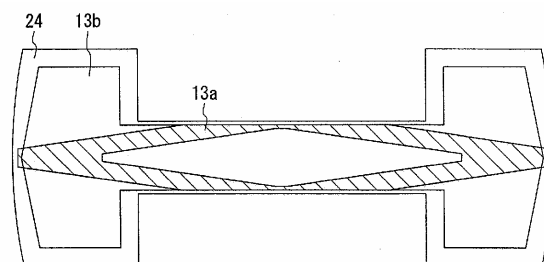
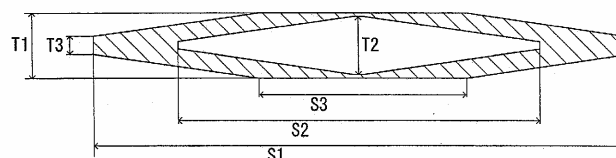
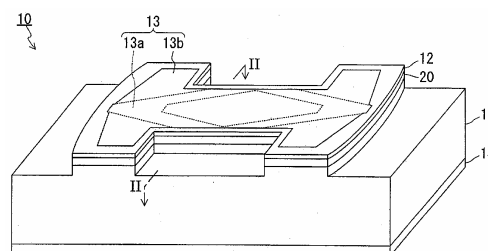
適用分野

レーザジャイロ、姿勢制御装置、ナビゲーション装置、手ぶれ補正装置、携帯用情報端末、航空機、自動車、バイク

- 目的 複数の方向へ出射するレーザ光の強度を個別に制御する。
- 効果 複数の方向へ出射するレーザ光の強度を個別に制御できるので、レーザジャイロを用いた各種の電子機器の利便性が向上する。

■ 技術概要
特記事項,図
など

半導体基板11と、その基板11上に形成された半導体多層膜20によって構成された活性層と、この活性層を構成する多層膜20に接する電極13a、13bとを主構成要素とし、活性層は4つの端面24a、24b、24c、24dによって構成される仮想の菱形を有して対向する2つ端面24a、24bからレーザ光51、52、53、54が出射され、電極13a、13bへの注入電流量にを变化させることによって、レーザ光51、52、53、54の強度が制御される。



- 主たる提供特許 特許等の名称 : 半導体レーザ装置
登録番号 :
出願番号 : 特願2006-088727 出願日 : 平成18年3月28日
公開番号 :

- 実施実績 ○有、無
- 提供形態 ○実施許諾、×権利譲渡

お問合せ先 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 知的財産チーム
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2
TEL 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp